

M2F60

600V 1.2A

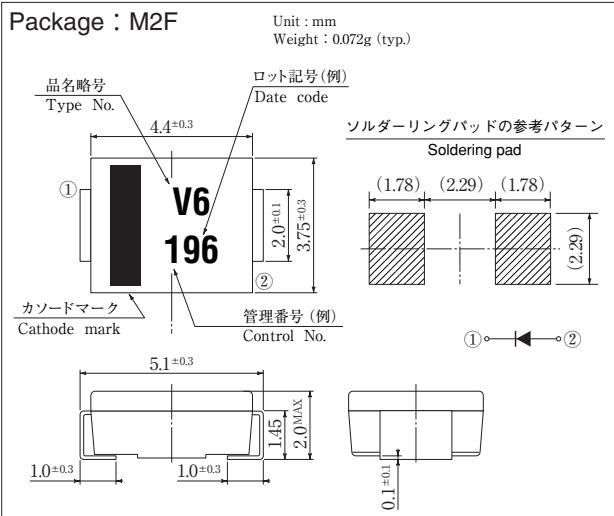
特長

- 耐湿性に優れ高信頼
- 自動実装対応

Feature

- High-Reliability
- for Auto-Mount

■外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



(製品上の表示については、捺印仕様をご確認ください)

■定格表 RATINGS

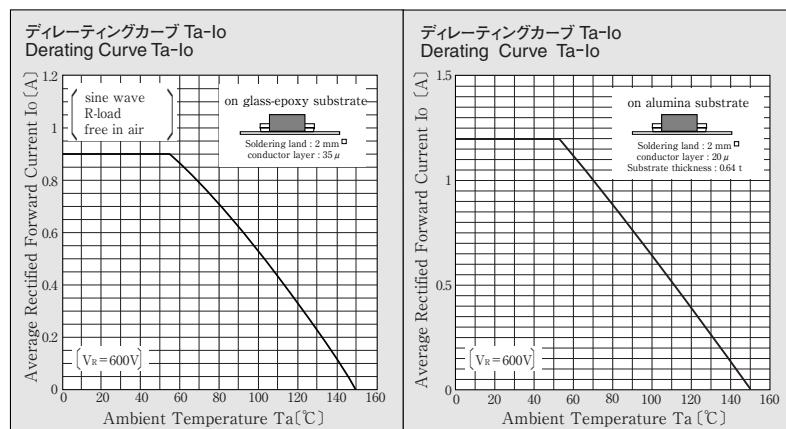
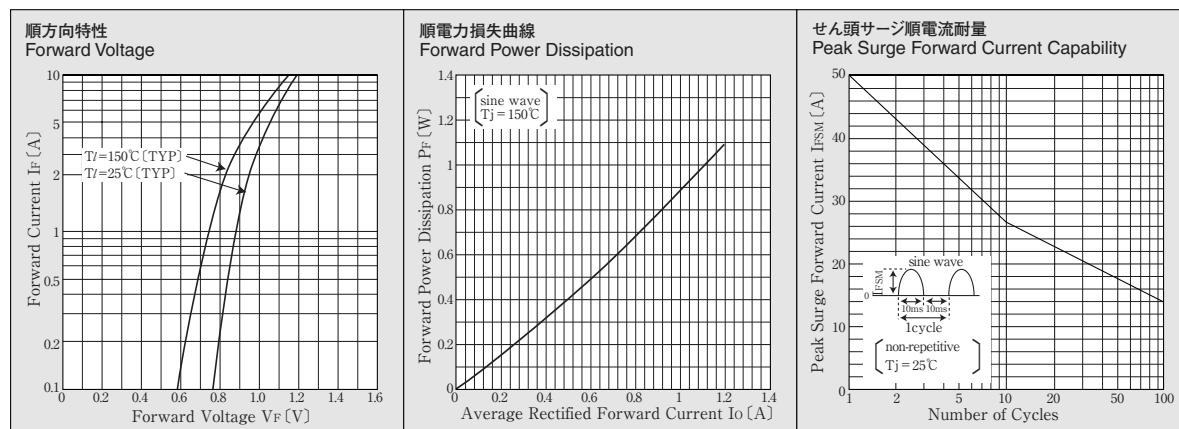
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合は $T_{l}=25^{\circ}\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	M2F60	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T _{stg}			-55~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	T _j			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, 50Hz sine wave, Resistance load	プリント基板実装 On glass-epoxy substrate Ta=55°C	0.9	A
			アルミナ基板実装 On alumina substrate Ta=51°C	1.2	
せん頭サーボ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, T _j =25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, T _j =25°C		50	A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I ² t	1ms ≤ t < 10ms T _j =25°C		7.4	A ² s

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合は $T_{l}=25^{\circ}\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F =1.2A, パルス測定 Pulse measurement	MAX 0.97	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R =600V, パルス測定 Pulse measurement	MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jl}	接合部・ケース間 Junction to Case	MAX 33	°C/W
	θ _{ja}	接合部・周囲間, アルミナ基板実装 Junction to Ambient, On alumina substrate	MAX 90	
	θ _{ja}	接合部・周囲間, プリント基板実装 Junction to Ambient, On glass-epoxy substrate	MAX 120	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- Sine wave は 50Hz で測定しています。
- 50Hz sine wave is used for measurements.
- 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。Typical は統計的な実力を表しています。
- Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.